

第 10 章 静电场 习题解答

10.1——10.18 思考题答案略

10.19 在某一时刻, (铀) U^{238} 发生放射性衰变而逸出 α 粒子, 变成新核 (钍) Th^{234} , α 粒子中心到新核 Th^{234} 中心的距离为 $9.0 \times 10^{-15} \text{ m}$ 。试问:

(1) 作用在 α 粒子上的力为多大?

(2) α 粒子的加速度为多大?

10.19 解: (1) α 粒子的电荷为 $2e$, 新核 (钍) Th^{234} 的电荷为 $90e$, 它们的中心相距为 $9.0 \times 10^{-15} \text{ m}$ 时, 作用在 α 粒子上的力为

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2e \cdot 90e}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 90 \times (1.6 \times 10^{-19})^2}{(9.0 \times 10^{-15})^2} = 512 \text{ N}$$

(2) α 粒子的质量为 $6.68 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 则 α 粒子的加速度为

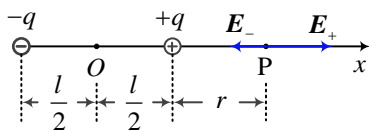
$$a = \frac{F}{m_\alpha} = \frac{512}{6.68 \times 10^{-27}} = 7.66 \times 10^{28} (\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$$

10.20 电偶极子由相距为 l 的两个点电荷 $+q$ 和 $-q$ 组成, 试求两电荷延长线上任一点的电场强度。

10.20 解: 如图所示, 取电偶极子轴线的中点为坐标原点 O , 轴的沿长线为 Ox 轴, 轴上任意一点 P 距原点 O 为 x , 点电荷 $+q$ 、 $-q$ 分别在 P 点处产生的场强 E_+ 、 E_- 为

$$E_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(x-l/2)^2} \mathbf{i}$$

$$E_- = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(x+l/2)^2} \mathbf{i}$$



习题10.20解图

因此点 P 的总场强为

$$E = E_+ + E_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{(x-l/2)^2} - \frac{q}{(x+l/2)^2} \right] \mathbf{i}$$

$$= \frac{2qxl}{4\pi\epsilon_0 x^4 \left(1 - \frac{l}{2x}\right)^2 \left(1 + \frac{l}{2x}\right)^2} \mathbf{i} = \frac{2ql}{4\pi\epsilon_0 x^3 \left(1 - \frac{l^2}{4x^2}\right)^2} \mathbf{i}$$

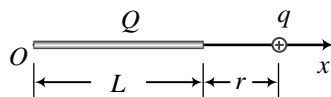
当 $x \gg l$ 时, 上式分母中 $\frac{l^2}{4x^2} \ll 1$, 所以

$$\mathbf{E} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2ql}{x^3} \mathbf{i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\mathbf{p}}{x^3}$$

式中 $\mathbf{p} = ql\mathbf{i}$ 称为电偶极矩。

不难看出, 如果场点 P 在 $-q$ 的左侧, 则场强大小的表达式不变, 但方向相反。

10.21 正电荷 Q 均匀分布在长度为 L 的细棒上, 将正点电荷 q 放在细棒延长线上距离细棒一端为 r 处, 取细棒另一端为坐标原点 O , 如图所示。



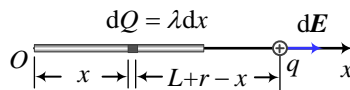
题10.21图

(1) 求均匀带电细棒在点电荷 q 处产生的电场强度和点电荷 q 所受的电场力。

(2) 如果点电荷 q 距离细棒很远 ($r \gg L$), 则该点的场强和点电荷所受电场力取何种形式?

10.21 解: (1) 在细棒上距离 O 为 x 处取一个长为 dx 的电荷元, 如图所示, 其所带电量为: $dQ = \frac{Q}{L} dx$, 则此电荷元在点电荷 q 处产生的电场强度为

$$d\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ}{(L+r-x)^2} \mathbf{i}$$



习题10.21解图

由场强叠加原理可知, q 处的总电场强度为

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{dx}{L(L+r-x)^2} \mathbf{i} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{L+r} \right) \mathbf{i}$$

所以点电荷受到的电场力为

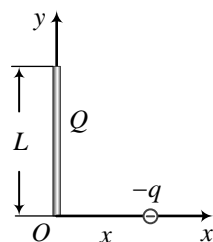
$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{L+r} \right) \mathbf{i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{r(L+r)} \mathbf{i}$$

(2) 如果 $r \gg L$, 则

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r(L+r)} \mathbf{i} \approx \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{i}$$

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} \approx \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{i}$$

10.22 正电荷 Q 均匀分布在长度为 L 的细棒上, 并取坐标系如图所示, 在 x 轴上任一点放置点电荷 $-q$, 试求点电荷所在位置的电场强度和该点电荷所受的电场力。



题10.22图

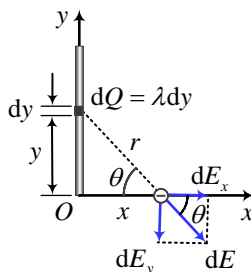
10.22 解: 根据已建立坐标系, 在细棒上距离 O 为 y 处取一个长为 dy 的电荷元, 如图所示, 其电量为: $dQ = \frac{Q}{L} dy$ 。由点电荷的场强公式, 该电荷元在 $-q$ 处产生的场强大小为

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \frac{dy}{x^2 + y^2}$$

它在 x 、 y 轴上的分量为

$$dE_x = dE \cos \theta = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \frac{xdy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$dE_y = -dE \sin \theta = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \frac{ydy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$



习题10.22解图

对上述两个分量分别积分, 得

$$E_x = \int dE_x = \int_0^L \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \frac{xdy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x} \frac{1}{\sqrt{x^2 + L^2}}$$

$$\begin{aligned} E_y &= \int dE_y = -\int_0^L \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \frac{ydy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \\ &= -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + L^2}} \right) \end{aligned}$$

所以该点的总电场强度为

$$\mathbf{E} = E_x \mathbf{i} + E_y \mathbf{j} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x} \frac{1}{\sqrt{x^2 + L^2}} \mathbf{i} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + L^2}} \right) \mathbf{j}$$

点电荷 $-q$ 受到的电场力为

$$\mathbf{F} = -q\mathbf{E} = \frac{-qQ}{4\pi\epsilon_0 x} \frac{1}{\sqrt{x^2 + L^2}} \mathbf{i} + \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + L^2}} \right) \mathbf{j}$$

10.23 负电荷 $-Q$ 均匀分布在一个半径为 R 的 $1/4$ 圆弧上, 试求圆心处的电场强度。

10.23 解: 建立坐标系如图中 (a) 所示, 在圆弧上任取一个弧长为 $dl = R d\theta$ 的电荷元, 其电量为

$$dq = \lambda dl = -\frac{Q}{\pi R/2} R d\theta = -\frac{2Q}{\pi} d\theta$$

由点电荷的场强公式, 该电荷元在圆心 O 点处产生的场强大小为

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|dq|}{R^2} = \frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} d\theta$$

因为 $dq < 0$, 所以其方向如图 (b) 所示, 它在 x 、 y 轴上的分量分别为

$$dE_x = dE \cos \theta = \frac{Q \cos \theta d\theta}{2\pi^2\epsilon_0 R^2}$$

$$dE_y = dE \sin \theta = \frac{Q \sin \theta d\theta}{2\pi^2\epsilon_0 R^2}$$

对上两式分别积分, 可得

$$E_x = \int dE_x = \int_0^{\pi/2} \frac{Q \cos \theta}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} d\theta = \frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2}$$

$$E_y = \int dE_y = \int_0^{\pi/2} \frac{Q \sin \theta}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} d\theta = \frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2}$$

所以圆心 O 点的场强为

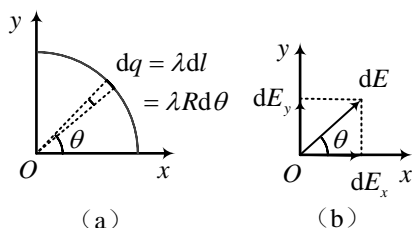
$$\mathbf{E} = E_x \mathbf{i} + E_y \mathbf{j} = \frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} (\mathbf{i} + \mathbf{j})$$

其大小为

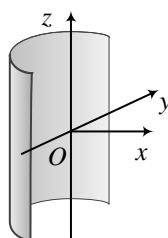
$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \frac{\sqrt{2}Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2}$$

10.24 真空中有半径为 R 的无限长半圆柱面均匀带正电, 电荷面密度为 σ , 如图所示。试求: 半圆柱中部轴线上 O 点的电场强度。

10.24 解: 无限长均匀带电半圆柱面可看成是由沿轴线分布的许多无限长带电“细”直线组成的。任取一条宽为 $dl = R d\theta$ 的均匀带电“细”



习题10.23解图



题10.24图

直线，如图所示（图中画出的是俯视图，图中半圆表示了无限长均匀带电的半圆柱面）。

则该带电“细直线”单位长度上所带电量为

$$d\lambda = \sigma dl = \sigma R d\theta$$

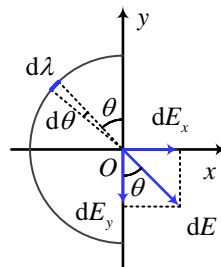
由“无限长”均匀带电的场强分布公式可知，它在轴线上 O 点产生的场强大小为

$$dE = \frac{d\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} d\theta$$

$d\mathbf{E}$ 的方向如图所示，它在 x 、 y 轴上的分量分别为

$$dE_x = dE \sin\theta = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \sin\theta d\theta$$

$$dE_y = -dE \cos\theta = -\frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \cos\theta d\theta$$



习题24解图

由对称性分析可知， y 方向的场强分量相互抵消， x 方向的分量为

$$E_x = \int_0^\pi dE \sin\theta = \int_0^\pi \frac{\sigma \sin\theta}{2\pi\epsilon_0} d\theta = \frac{\sigma}{\pi\epsilon_0}$$

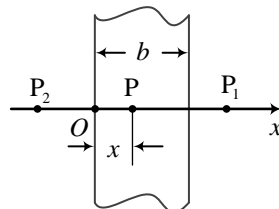
所以轴线上 O 点的场强为

$$\mathbf{E} = E_x \mathbf{i} = \frac{\sigma}{\pi\epsilon_0} \mathbf{i}$$

上式表明场强的方向沿 x 轴的正向。

10.25 如图所示，厚度为 b 的“无限大”带电平板，其电荷体密度为 $\rho = kx$ ($0 \leq x \leq b$)，式中 k 为一正的常量。试求：

- (1) 平板外任意点 P_1 和 P_2 处的电场强度；
- (2) 平板内任一点 P 处电场强度；
- (3) x 轴上场强为零的点在何处？



题10.25图

10.25 解：此带电平板可看成是由许多“无限大”均匀带电“薄板”组成的集合。在距离 O 点为 x 处取一个厚度为 dx 的无限大“薄板”，则此“薄板”上的电荷面密度为

$$d\sigma = \rho dx = kx dx$$

该带电“薄板”产生的场强方向垂直于“薄板”向外，大小为

$$dE = \frac{d\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{kx}{2\epsilon_0} dx$$

(1) 由对称性分析可知, 平板外两侧场强大小处处相等, 方向垂直于平板且背离平板, 所以由场强叠加原理, 可得 P_1 和 P_2 处的场强大小为

$$E_{p1} = E_{p2} = \int_0^b \frac{kx}{2\varepsilon_0} dx = \frac{k}{4\varepsilon_0} b^2$$

(2) 同理, 对于平板内的任意点 P 处的场强大小为

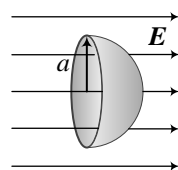
$$E_p = \int_0^x \frac{kx}{2\varepsilon_0} dx - \int_x^b \frac{kx}{2\varepsilon_0} dx = \frac{k}{2\varepsilon_0} \left(x^2 - \frac{b^2}{2} \right) \quad 0 \leq x \leq b$$

(3) 由上述讨论可知, $\mathbf{E} = 0$ 的点只可能在板内, 令 $E_p = 0$, 有: $x^2 = \frac{b^2}{2}$

即场强为零的点在 $x = \frac{b}{\sqrt{2}}$ 处。

10.26 电场强度为 \mathbf{E} 的均匀电场与半径为 a 的半球面的轴线平行, 如图所示。试计算通过此半球面的电通量。

10.26 解: 由于通过半球面的电场线全部通过半径为 a 的圆平面, 即通过半球面和圆平面的电通量相等, 即



题10.26图

$$\Phi_e = \iint_{\text{半球面}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\text{平面}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \pi a^2 E$$

10.27 在半径分别为 R_1 和 R_2 (设 $R_1 < R_2$) 的两个同心球面上, 分别均匀带电 Q_1 和 Q_2 , 求空间的场强分布, 并作出 $E \sim r$ 关系曲线。

10.27 解: 由题意可知, 电荷及其产生的场强分布均具有球对称性, 为此取一个半径为 r 的同心球面为高斯面。由对称性可知, 该高斯面上各点的场强大小处处相等, 方向沿径向。根据高斯定理

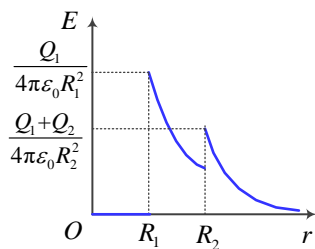
$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \oiint_S E dS \cos 0^\circ = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q$$

即:

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \sum q$$

当 $0 < r < R_1$ 时, 高斯面内无电荷, $\sum q = 0$, 故

$$E_1 = 0$$



习题10.27解图: $E \sim r$ 曲线

当 $R_1 < r < R_2$ 时, $\sum q = Q_1$, 故: $E_2 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

当 $r > R_2$ 时, $\sum q = Q_1 + Q_2$, 故: $E_3 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

电场强度随场点位置 r 的变化曲线如图所示。

10.28 有一半径为 R 的带电球体, 电荷体密度随半径变化规律为: $\rho = kr$, 其中 k 为正的常数, 试求此带电球体产生的电场强度分布。

10.28 解: 由于带电球体的电荷密度只与 r 有关, 故电荷及其产生的场强分布均具有球对称性。为此可作一个半径为 r 的同心球面作为高斯面, 由高斯定理可得

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q$$

即高斯面上任意一点的场强大小为

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sum q \quad (1)$$

为求高斯面内的电量 $\sum q$, 可将带电球体看成是由许多均匀带电的“薄球壳”组成的集合。先考虑一个半径为 r , 厚度为 dr 的“薄球壳”, 该“薄球壳”内所带的电荷量为

$$dq = \rho dV = kr \cdot 4\pi r^2 dr = 4\pi k r^3 dr$$

对于球面外的场点, 高斯面半径 $r > R$, 所以高斯面内的电荷量就是整个带电球体的电量, 即

$$\sum q = \int dq = \int_0^R 4\pi k r^3 dr = k\pi R^4$$

代入 (1) 式, 可得球面外任意一点的场强大小为

$$E = \frac{kR^4}{4\epsilon_0 r^2} \quad (r > R)$$

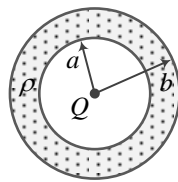
对于球体内的场点, $r < R$, 高斯面内的电量为

$$\sum q = \int dq = \int_0^r 4\pi k r^3 dr = k\pi r^4$$

代入 (1), 可得球面内任意一点的场强大小为

$$E = \frac{kr^2}{4\varepsilon_0} \quad (r < R)$$

10.29 如图所示, 有一带电球壳, 内、外半径分别为 a 和 b , 电荷体密度 $\rho = A/r$, 另外在球心处还有一点电荷 Q 。试证明当 $A = \frac{Q}{2\pi a^2}$ 时, 球壳区域内的电场强度 E 的大小与半径 r 无关。



题10.29图

10.29 解: 由题意可知, 电荷分布具有球对称性, 故可断定场强分布也具有球对称性。为此作一个半径为 r 的同心球面为高斯面, 由高斯定理可得

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\sum q}{\varepsilon_0}$$

显然, 当 $a < r < b$ 时, 式中

$$\sum q = Q + \int_a^r \frac{A}{r} \cdot 4\pi r^2 dr = Q + 2\pi A(r^2 - a^2)$$

所以球壳区域内任意一点的场强为

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{A}{2\varepsilon_0} - \frac{Aa^2}{2\varepsilon_0 r^2}$$

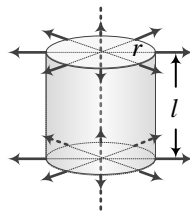
由上式可知, 当 $A = \frac{Q}{2\pi a^2}$ 时, 球壳区域内 $E = \frac{A}{2\varepsilon_0}$, 与 r 无关。

10.30 设气体放电形成的等离子体在圆柱体内的体电荷分布可用下式表示

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{\left[1 + (r/a)^2\right]^2}$$

式中 r 为到中心轴线的距离, ρ_0 为轴线上的电荷体密度, a 为常数 (它是 ρ 减小到 $\rho_0/4$ 时到轴线的距离)。试计算其场强分布。

10.30 解: 由于圆柱体内的电荷分布只与 r 有关, 故可推知电荷及其产生的场强分布均具有“无限长”的轴对称性。为此取一个与等离子圆柱体同轴、半径为 r 、长为 l , 且底面垂直于轴线的闭合圆柱面为高斯面, 如图所示。则圆柱面侧面上各点场强大小相等, 方向沿径向向外, 由高斯定理可得



习题10.30解图

$$\begin{aligned}\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{\text{侧面}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{\text{上底面}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{\text{下底面}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iint_{\text{侧面}} E dS = E S_{\text{侧面}} = E 2\pi r l = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q\end{aligned}$$

所以

$$E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0 r l} \sum q \quad (1)$$

式中 $\sum q$ 为高斯面内的总电荷。为求 $\sum q$ ，可将该高斯面所围的圆柱体看成是由许多半径为 r 、厚度为 dr 、长为 l 的薄圆筒组成的集合，该薄圆筒内所带的电量为

$$dq = \rho(r) dV = \rho(r) 2\pi r l dr$$

所以高斯面内所带的总电量为

$$\sum q = \int dq = \int_0^r \rho(r) 2\pi r l dr = \int_0^r \frac{\rho_0}{\left[1 + (r/a)^2\right]^2} 2\pi r l dr = \frac{\pi \rho_0 l a^2 r^2}{a^2 + r^2}$$

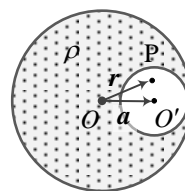
将此代入 (1) 式，可得场强分布为

$$E = \frac{1}{2\pi r l \varepsilon_0} \frac{\pi \rho_0 l a^2 r^2}{a^2 + r^2} = \frac{\rho_0 a^2 r}{2\varepsilon_0 (a^2 + r^2)}$$

10.31 一个均匀带电球体，其电荷体密度为 ρ ($\rho > 0$)，若以 \mathbf{r} 代表从球心 O 指向球内一点的位矢。

(1) 试证明： \mathbf{r} 处的电场强度为 $\mathbf{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \mathbf{r}$ ；

(2) 若在这球内挖去一部份电荷，形成一个球形空腔，如图所示。



题10.31图

试证明：这空腔内各点的电场是均匀的，其场强为 $\mathbf{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \mathbf{a}$ ，式中 \mathbf{a} 表示由球心 O 指向空腔中心 O' 的矢量。

10.31 证明：(1) 均匀带电球体内的电荷分布及其产生的场强分布具有球对称性。为此作一个半径为 r 的同心球面为高斯面，则由高斯定理

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^r \rho \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{4\pi\rho}{3\varepsilon_0} r^3$$

所以高斯面上各点场强的大小为: $E = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r$, 又因场强的方向沿径向向外, 所以

$$\mathbf{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \mathbf{r}$$

(2) 从产生电场的效果来看, 在均匀带电球体内部挖出一个球形空腔后产生的电场分布, 等效于一个电荷密度为 ρ 的均匀带电大球体和一个在空腔处电荷密度为 $-\rho$ 均匀带电小球体产生的两个场强的叠加 (矢量和)。

设两个球心 O 和 O' 到空腔内任意点 P 的矢径分别为 \mathbf{r}_1 和 \mathbf{r}_2 , 如图所示, 则由 (1) 可知: 电荷密度为 ρ 的大球体单独在 P 点产生的场强为

$$\mathbf{E}_1 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \mathbf{r}_1$$

电荷密度为 $-\rho$ 的小球单独在 P 点产生的场强为

$$\mathbf{E}_2 = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0} \mathbf{r}_2$$

所以 P 点的总场强为

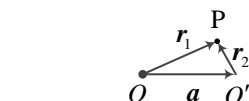
$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$$

又由于: $\mathbf{a} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$, 因此

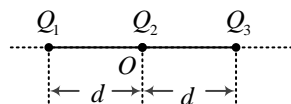
$$\mathbf{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \mathbf{a}$$

此式表明空腔里的场强是均匀的。

10.32 如图所示, 有三个点电荷 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 沿一条直线等间距分布, 已知其中任一点电荷所受合力均为零, 且 $Q_1 = Q_3 = Q$ 。试求在固定 Q_1 、 Q_3 的情况下, 将 Q_2 从 O 点移到无限远处时外力所做的功。



习题10.31解图



题10.32图

10.32 解: 由题意可知, Q_1 所受的合力为零, 即

$$Q_1 \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 d^2} + Q_1 \frac{Q_3}{4\pi\varepsilon_0 (2d)^2} = 0$$

由此解得

$$Q_2 = -\frac{1}{4}Q_3 = -\frac{1}{4}Q$$

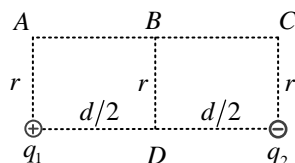
由点电荷的电势分布及电势叠加原理, 可得电荷 Q_1 、 Q_3 在 O 点产生的电势为

$$V_o = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 d} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 d}$$

所以将 Q_2 从点 O 移到无限远处时外力 (克服电场力) 所做的功为

$$A_{\text{外力}} = -Q_2(V_o - V_\infty) = -Q_2 V_o = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 d}$$

10.33 如图所示, 已知 $r=6\text{cm}$, $d=8\text{cm}$, $q_1=3\times 10^{-8}\text{C}$, $q_2=-3\times 10^{-8}\text{C}$ 。试求:



题10.33图

(1) 将电荷量为 $2\times 10^{-9}\text{C}$ 的点电荷从 A 点移到 B 点时, 电场力做的功;

(2) 将此点电荷从 C 点移到 D 点时, 电场力做的功。

10.33 解: 由点电荷的电势公式和电势叠加原理, 可得 q_1 、 q_2 在 A、B、C、D 四个点产生的电势分别为

$$V_A = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + d^2}} = 1.8\times 10^3 \text{ V}$$

$$V_B = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + (d/2)^2}} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + (d/2)^2}} = 0$$

$$V_C = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + d^2}} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r} = -1.8\times 10^3 \text{ V}$$

$$V_D = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 (d/2)} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 (d/2)} = 0$$

(1) 将点电荷 q_0 由 A 点移到 B 点时, 电场力做功为

$$A_{AB} = q_0(V_A - V_B) = q_0 V_A = 3.6\times 10^{-6} \text{ J}$$

(2) 将点电荷 q_0 由 C 点移到 D 点时, 电场力做功为

$$A_{CD} = q_0(V_C - V_D) = q_0 V_C = -3.6\times 10^{-6} \text{ J}$$

10.34 真空中有一半径为 R 的半圆细环，均匀带电 Q 。设无限远处为电势零点，则圆心 O 处的电势为多少？若将一带电量为 q 的点电荷从无限远处移到圆心 O 点，试求电场力做的功。

10.34 解： 在半圆环上任取一个电荷元 dq ，它在圆心 O 处产生的电势为

$$dV_o = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R}$$

所以圆心 O 处的总电势为

$$V_o = \int_0^Q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^Q dq = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

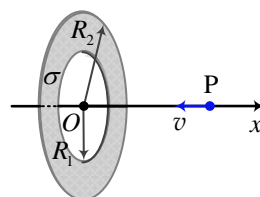
将一带电量为 q 的点电荷从无限远处移到圆心 O 点时，电场力做功为

$$A = q(V_\infty - V_o) = -\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 R}$$

10.35 如图所示，有一个内外半径分别为 R_1 和 R_2 的均匀带电圆环，电荷面密度为 σ ($\sigma > 0$)。

(1) 计算通过环心垂直于环面的轴线上任意一点 P 的电势；

(2) 若有一质子沿轴线从无限远处射向带正电的圆环，要使质子能穿过圆环，它的初速度至少是多少？



题10.35图

10.35 解： (1) 在带电圆环上任取一个半径为 r 、宽度为 dr 的细圆环，其所带电量为

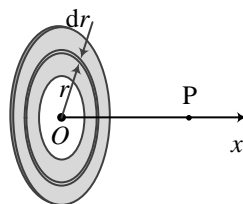
$$dq = \sigma dS = \sigma 2\pi r dr$$

它在轴线上任意一点 P 处产生的电势为

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{1/2}} = \frac{\sigma r dr}{2\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{1/2}}$$

由电势叠加原理， P 点的总电势为

$$V = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma r dr}{2\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{1/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{R_2^2 + x^2} - \sqrt{R_1^2 + x^2} \right]$$



习题10.35解图

(2) 由上述结果可知，在带电圆环圆心 O 处的电势为

$$V_o = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (R_2 - R_1)$$

为使质子能够穿过圆环中心，其在圆环中心处的动能 E_k 必大于零。根据能量守恒定律，质子在轴上无限远处的初速度 v_0 应满足

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + eV_\infty = E_k + eV_o \geq eV_o$$

所以有

$$v_0 \geq \sqrt{\frac{2eV_o}{m}} = \sqrt{\frac{e\sigma}{\epsilon_0 m}(R_2 - R_1)}$$

上式表明质子欲穿过环心，其速率不能小于 $\sqrt{\frac{e\sigma}{\epsilon_0 m}(R_2 - R_1)}$ 。

10.36 两个同心均匀带电球面的半径分别为 R_1 和 R_2 （设 $R_1 < R_2$ ），所带电量分别为 Q_1 和 Q_2 。试求：

- (1) 空间各区域的电势分布，并画出 $V \sim r$ 曲线；
- (2) 两球面的电势差。

10.36 解：（1）由高斯定理可求得电场强度的分布为

$$E_1 = 0 \quad r < R_1$$

$$E_2 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad R_1 < r < R_2$$

$$E_3 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad r > R_2$$

场强的方向均沿径向。由电势的定义式可得，当 $r < R_1$ 时

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_r^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_r^{R_1} \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{l} + \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{l} + \int_{R_2}^\infty \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{l} \\ &= 0 + \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_2}^\infty \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \end{aligned}$$

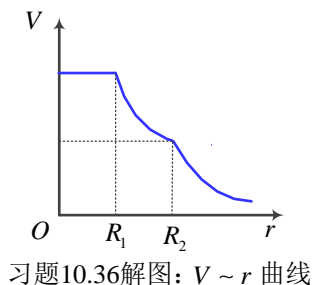
当 $R_1 < r < R_2$ 时

$$V_2 = \int_r^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_r^{R_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{l} + \int_{R_2}^\infty \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{l}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_r^{R_2} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_2}^{\infty} \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\
 &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}
 \end{aligned}$$

当 $r > R_2$ 时

$$V_3 = \int_r^{\infty} \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{l} = \int_{R_2}^{\infty} \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$



由此可画出电势分布曲线如图所示。

(2) 两球面之间的电势差为

$$U_{12} = \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

10.37 一半径为 R 的无限长均匀带电圆柱体, 其电荷体密度为 ρ 。现取圆柱体表面电势为零。试求: 圆柱体内外的电势分布并画出电势分布曲线。

10.37 解: 无限长均匀带电圆柱体的场强分布具有轴对称性。取高为 l 、半径为 r 且与带电圆柱体同轴、底面与轴线垂直的闭合圆柱面为高斯面, 由高斯定理可得

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\text{侧面}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E 2\pi r l = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q$$

所以

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r l} \sum q$$

当 $r < R$ 时, $\sum q = \rho V = \rho \pi r^2 l$, 所以

$$E = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$$

当 $r > R$ 时, $\sum q = \rho \pi R^2 l$, 所以

$$E(r) = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r}$$

若取棒表面, 即 $r = R$ 处为零电势参考点, 则由电势的定义式, 可得电势分布为

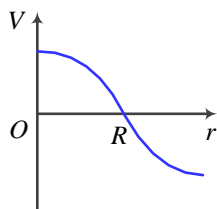
当 $r < R$ 时

$$V = \int_r^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_r^R \frac{\rho r}{2\epsilon_0} dr = \frac{\rho}{4\epsilon_0} (R^2 - r^2) > 0$$

当 $r > R$ 时

$$V = \int_r^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_r^R \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r} dr = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \ln \frac{R}{r} < 0$$

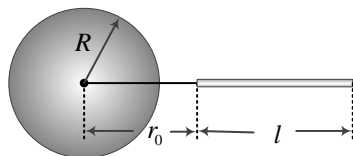
电势 V 随空间位置 r 的分布曲线如图所示。



习题10.37解图: $V \sim r$ 曲线

显然本题中不能取无限远处为零电势点, 因为这将导致各点电势趋于无限大。

10.38 如图所示, 半径为 R 的均匀带电球面, 带电量为 Q , 沿半径方向有一均匀带电细线, 线电荷密度为 λ , 长度为 l , 细线近端离球心距离为 r_0 , 设球面和细线上的电荷分布不相互影响。试求细线所受球面电荷的电场力和带电细线在该电场中的电势能 (设无限远处的电势为零)。

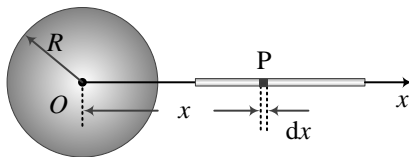


题10.38图

10.38 解: 设 x 轴沿细线方向, 原点在球心处。

由高斯定理可得, 均匀带电球面在带电细线上点 P 处产生的场强为

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \mathbf{i}$$



习题10.38解图

在该处的带电细线上取一电荷元 $dq = \lambda dx$, 它受电场力的大小为

$$dF = E \cdot dq = \frac{Q\lambda}{4\pi\epsilon_0 x^2} dx$$

由于每个电荷元所受的电场力方向均沿 x 轴方向, 故均匀带电细线所受电场力的合力为

$$F = \int dF = \frac{Q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_0}^{r_0+l} \frac{dx}{x^2} = \frac{Q\lambda}{4\pi\epsilon_0 r_0(r_0+l)}$$

方向沿 x 轴正方向。

若以无限远处为电势零点, 则均匀带电球面在细线上点 P 处产生的电势为

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x}$$

所以该处的电荷元 $dq = \lambda dx$ 具有的电势能为

$$dW = Vdq = \frac{Q\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x}$$

故带电细线在该电场中的总电势能为

$$W = \int dW = \frac{Q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_0}^{r_0+l} \frac{dx}{x} = \frac{Q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_0+l}{r_0}\right)$$

10.39 两个同心的带电球面、半径分别为 $R_1 = 10\text{cm}$ ， $R_2 = 40\text{cm}$ ，其电势分别为 $V_1 = 40\text{V}$ ， $V_2 = -20\text{V}$ 。试求：电势为零的球面半径 R_0 以及该球面上的电场强度。

10.39 解：由电势分布的连续性可知，电势为零的球面一定在两个同心的带电球面之间，设其半径为 R_0 ($R_1 < R_0 < R_2$)。同时假设半径为 R_1 的球面上带有 Q 的电荷，则由高斯定理可知，在 $R_1 < r < R_2$ 区域中的电场强度大小为

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \quad (1)$$

方向沿径向。由此可得半径为 R_1 球面的电势为

$$V_1 = \int_{R_1}^{R_0} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_{R_1}^{R_0} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_0} \right) = 40\text{V} \quad (2)$$

半径为 R_2 球面的电势为

$$V_2 = \int_{R_2}^{R_0} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_{R_2}^{R_0} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_0} \right) = -20\text{V} \quad (3)$$

联立②③式，求解可得电势为零的球面半径为

$$R_0 = 20\text{cm}$$

同时还可求得 $Q = 32\pi\epsilon_0$ ，将此代入①式，可得电势为零的球面上电场强度的大小为

$$E|_{r=R_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R_0^2} = 200 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

方向沿径向相外。

10.40 如题 10.40 图所示，一带电球壳的内外半径分别为 a 和 b ，壳体中的电荷密度按 $\rho = \rho_0 r$ 的规律进行分布，式中 ρ_0 为大于 0 的常量， r 是球壳内部任一点到球心的距离。试求

(1) 带电壳体内外的场强分布；

(2) 球壳内外表面之间的电势差。

10.40 解: (1) 由对称性分析可知, 本题中场强分布具有球对称性, 场强方向沿径向向外。为此, 作一个半径 r 的同心球面为高斯面

S , 由高斯定理: $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum Q$, 得

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sum Q$$

式中的 $\sum Q$ 是高斯面 S 所包围的电量的代数和。

当 $r < a$ 时, 即在球壳的空腔内, $\sum Q = 0$, 所以: $E = 0$

当 $a < r < b$, 即在球壳内部, $\sum Q = \int \rho dV = \int_a^r \rho_0 r \cdot 4\pi r^2 dr = \pi\rho_0(r^4 - a^4)$

所以
$$E = \frac{\rho_0}{4\epsilon_0} \frac{r^4 - a^4}{r^2}$$

当 $r > b$ 时, 即在球壳外部, $\sum Q = \int \rho dV = \int_a^b \rho_0 r \cdot 4\pi r^2 dr = \pi\rho_0(b^4 - a^4)$

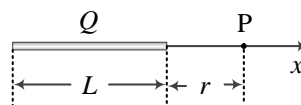
所以
$$E = \frac{\rho_0}{4\epsilon_0} \frac{b^4 - a^4}{r^2}$$

(2) 球壳内外表面的电势差为

$$\begin{aligned} U_{ab} &= \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \frac{\rho_0}{4\epsilon_0} \frac{r^4 - a^4}{r^2} dr \\ &= \frac{\rho_0}{4\epsilon_0} \left[\frac{1}{3}(b^3 - a^3) + a^4 \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) \right] = \frac{\rho_0}{4\epsilon_0} \left(\frac{1}{3}b^3 - \frac{4}{3}a^3 + \frac{a^4}{b} \right) \end{aligned}$$

10.41 正电荷 Q 均匀分布在长度为 L 的细棒上, 如题

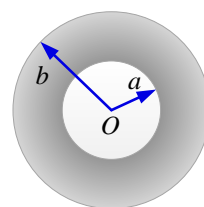
10.41 图所示, 点 P 是细棒延长线上的任意一点, 到细棒一端的距离为 r , 试求该点的电势, 并利用场强与电势的微分关系求 P 点的电场强度。



题10.41图

10.41 解: 以细棒的左端点为坐标原点 O , 建立 Ox 坐标轴, 在细棒上距离 O 点为 x 处,

取一个长为 dx 的电荷元: $dq = \frac{Q}{L} dx$ 。若以无限远处为零电势点, 则 dq 在 P 点产生的电势为

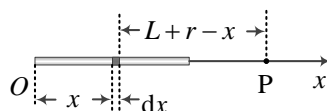


题 10.40 图

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r+L-x} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qdx}{L(r+L-x)}$$

由电势叠加原理, 可得 P 点的总电势为

$$V = \int_0^L \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dx}{L(r+L-x)} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{r+L}{r}$$



习题10.41解图

由对称性分析可知, P 点的场强沿 x 轴方向, 所以由电势与场强的微分关系, 可得 P 点的场强为

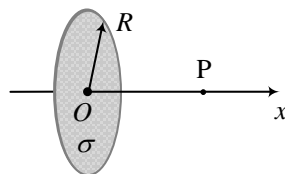
$$\mathbf{E} = -\frac{dV}{dr} \mathbf{i} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{L+r} \right) \mathbf{i}$$

10.42 如题 10.42 图所示, 有一半径为 R , 电荷面密度为 σ ($\sigma > 0$) 的均匀带电圆盘。

(1) 求圆盘轴线上的电势分布;

(2) 根据电势与场强的微分关系, 求圆盘轴线上的场强分布;

(3) 当 $R = 3.00 \times 10^{-2} \text{ m}$ 、 $\sigma = 2.00 \times 10^{-5} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$ 时, 求轴线上离盘心为 30.0 cm 处的电势和电场强度的大小。



习题10.42图

10.42 解: (1) 在圆盘上距离盘心为 r 处, 取一个面积为 $dS = r dr d\theta$ 的电荷元, 其所带电荷量为 $dq = \sigma dS = \sigma r dr d\theta$, 它在轴线上 P 点处产生的电势为

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + r^2}} = \frac{\sigma r dr d\theta}{2\epsilon_0 \sqrt{x^2 + r^2}}$$

由电势叠加原理, 可得整个均匀带电圆盘在轴线上的电势分布为

$$V = \int dV = \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{\sigma r}{2\epsilon_0 \sqrt{x^2 + r^2}} dr d\theta = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{R^2 + x^2} - x)$$

(2) 由对称性分析可知, P 点的场强沿 x 轴方向, 根据电势与场强的微分关系可得 P 点场强为

$$\mathbf{E} = -\frac{dV}{dx} \mathbf{i} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \mathbf{i}$$

(3) 将 $R = 3.00 \times 10^{-2} \text{ m}$ 、 $\sigma = 2.00 \times 10^{-5} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$ 上述结论, 可得轴线上离盘心为 30.0 cm 处的电势和电场强度的大小分别为

$$V = 1.69 \times 10^3 \text{ V} \quad \mathbf{E} = 5.61 \times 10^3 \mathbf{i} \text{ V/m}$$